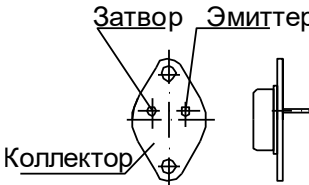
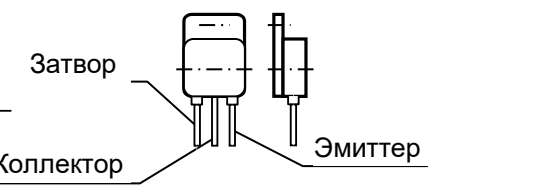
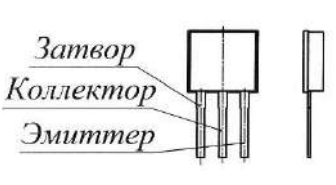


Мощные IGBT транзисторы 2Е802

Мощные кремниевые эпитаксиально-планарные п-канальные биполярные транзисторы с изолированным затвором 2Е802 АЕЯР.4321140.283ТУ: 2Е802А в металlostеклянных корпусах КТ-9; 2Е802А1 в металlostеклянных корпусах КТ-97В; 2Е802В, 2Е802Г в металlostеклянных корпусах КТ-97С; 2Е802В3, 2Е802Г3 в беспотенциальных герметичных металлокерамических корпусах КТ-111С-2.02 с планарными гибкими плоскими выводами **предназначенные для работы в качестве силовых ключей в аппаратуре специального назначения.**

Транзисторы изготавливаются двух типов шести типономиналов. К первому типу относятся транзисторы 2Е802А, 2Е802А1 структуры РТ. Ко второму типу относятся транзисторы 2Е802В, 2Е802В3, 2Е802Г, 2Е802Г3 структуры NPT. Категория качества приборов – «ВП» (приемка «5»).

		
2Е802А в корпусе КТ-9 (аналог ТО-3) Масса не более 20 г	2Е802А1 в корпусе КТ-97В (аналог ТО-254); 2Е802В, 2Е802Г в корпусе КТ-97С (аналог ТО-258) Масса не более 7,5 г (КТ-97В), 10 г (КТ-97С)	2Е802В3, 2Е802Г3 в корпусе КТ-111С-2.02 Масса не более 3,6 г

Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации

Наименование изделия	Тип корпуса	$U_{КЭК\text{ max, В}}$	$I_{К\text{ max, А}}$	$I_{КИ\text{ max, А}}$	$U_{ЗЭ\text{ проб max, В}}$	$P_{К\text{ max, Вт}}$
2Е802А	КТ-9	600	23	46	± 20	100
2Е802А1	КТ-97В	600	23	46	± 20	100
2Е802В	КТ-97С	1200	45	90	± 25	160
2Е802В3	КТ-111С-2.02	1200	45	90	± 25	160
2Е802Г	КТ-97С	600	45	90	± 25	160
2Е802Г3	КТ-111С-2.02	600	45	90	± 25	160

Основные электрические параметры при нормальной температуре

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА ($R_{ЗЭ}=0\text{ Ом}$, $U_{КЭК} = U_{КЭК\text{ max}}$)	$I_{КЭК}$	-	0,25
Ток утечки затвора, нА ($U_{ЗЭ} = U_{ЗЭ\text{ проб max}}$)	$I_{З. ут}$	-	100
Пороговое напряжение затвора, В ($U_{КЭ} = U_{ЗЭ}$, $I_{К} = 1\text{ мА}$)	$U_{ЗЭ\text{ пор}}$	3	6
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В	$U_{КЭ\text{ нас}}$		

2Е802А, 2Е802А1 ($I_K = 12 \text{ A}$, $U_{3Э} = 15\text{В}$)		-	2,7
2Е802В, 2Е802В3 ($I_K = 20 \text{ A}$, $U_{3Э} = 15\text{В}$)		-	3,0
2Е802Г, 2Е802Г3 ($I_K = 25 \text{ A}$, $U_{3Э} = 15\text{В}$)		-	2,7
Время спада, мкс ($U_{3Э} = 15 \text{ В}$, $R_3 = 15 \text{ Ом}$, $L = 4,5 \text{ мГн}$, $I_K = 10 \text{ А}$)	$\tau_{сп}$		
2Е802А, 2Е802А1 ($U_{КЭ} = 100 \text{ В}$)		-	0,15
2Е802В, 2Е802В3, 2Е802Г, 2Е802Г3 ($U_{КЭ} = 200 \text{ В}$)		-	0,15
Время рассасывания, мкс ($U_{3Э} = 15 \text{ В}$, $R_3 = 15 \text{ Ом}$, $L = 4,5 \text{ мГн}$, $I_K = 10 \text{ А}$)	$\tau_{рас}$		
2Е802А, 2Е802А1 ($U_{КЭ} = 100 \text{ В}$)		-	0,25
2Е802В, 2Е802В3, 2Е802Г, 2Е802Г3 ($U_{КЭ} = 200 \text{ В}$)		-	0,45
Тепловое сопротивление перехода-корпус, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Т \text{ п-к}}$		
2Е802А, 2Е802А1		-	1,25
2Е802В, 2Е802В3, 2Е802Г, 2Е802Г3		-	0,78